(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. April 2004 (15.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/032245 A1

(51) Internationale Patentklassifikation[7]: H01L 29/786, 21/336

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003131

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. September 2003 (19.09.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 45 153.2 27. September 2002 (27.09.2002) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St. Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **KAKOSCHKE, Ronald** [DE/DE]; Karlsbergstrasse 11, 81475 München (DE).

(74) Anwälte: **KINDERMANN, Peter** usw.; Patentanwälte Kindermann, Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(national)*: CN, JP, KR, SG, US.

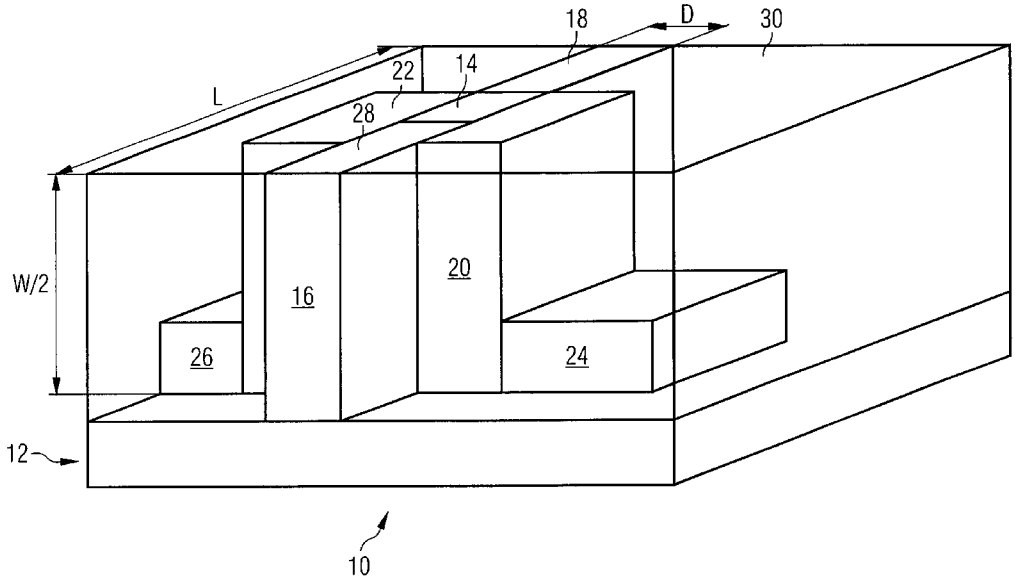
(84) Bestimmungsstaaten *(regional)*: europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:
— *mit internationalem Recherchenbericht*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: INTEGRATED FIELD-EFFECT TRANSISTOR COMPRISING TWO CONTROL REGIONS, USE OF SAID FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTER FELDEFFEKTTRANSISTOR MIT ZWEI STEUERBEREICHEN, VERWENDUNG DIESES FELDEFFEKTTRANSISTORS UND HERSTELLUNGSVERFAHREN



(57) Abstract: The invention relates to, inter alia, a field-effect transistor (10) which is produced by means of the SOI technique and the salicide technique as a double-gate-transistor (10). Said transistor (10) is suitable for turn-on voltages higher than five volts, or even higher than nine volts, and requires only a very small chip surface.

(57) Zusammenfassung: Erläutert wird unter anderem ein Feldeffekttransistor (10), der unter Verwendung der SOI-Technik und der Salicidtechnik als sogenannter Double-Gate-Transistor (10) hergestellt wird. Der Transistor (10) ist für Schaltspannungen grösser als fünf Volt oder sogar grösser als neun Volt geeignet und benötigt nur eine sehr kleine Chipfläche.

WO 2004/032245 A1